



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1015

对应国外型号
2SC1015

主要用途

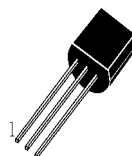
作音频放大、激励级放大。(与 H1815 互补)

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	400mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-50V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-50V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-150mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—集电极, C
3—基极, B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{\text{CB}}=-50\text{V}$, $I_{\text{E}}=0$
I_{EB0}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}$, $I_{\text{C}}=0$
H_{FE}	直流电流增益	70 25		700		$V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_{\text{C}}=-2\text{mA}$ $V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_{\text{C}}=-150\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			-0.3	V	$I_{\text{C}}=-100\text{mA}$, $I_{\text{B}}=-10\text{mA}$
$V_{\text{BE(sat)}}$	基极—发射极饱和电压			-1.1	V	$I_{\text{C}}=-100\text{mA}$, $I_{\text{B}}=-10\text{mA}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-50			V	$I_{\text{C}}=-100\mu\text{A}$, $I_{\text{E}}=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-50			V	$I_{\text{C}}=-1\text{mA}$, $I_{\text{B}}=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_{\text{E}}=-10\mu\text{A}$, $I_{\text{C}}=0$
f_{T}	特征频率	80			MHz	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_{\text{C}}=-1\text{mA}$

分档及其标志

O	Y	GR	BL1	BL2
70—140	120—240	200—400	380—510	480—700